

КТ503В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Область применения: усилители низкой частоты, операционные и дифференциальные усилители, преобразователи, импульсные устройства.

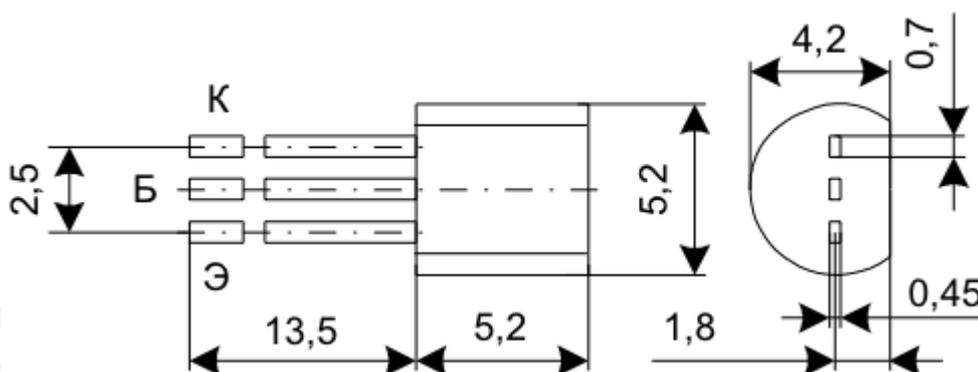
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Тип корпуса: КТ-26 (ТО92).

Технические условия: аА0.336.183 ТУ/02.



Основные технические характеристики транзистора КТ503В:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ}=5$ В, $I_{э}=10$ мА: 40... 120;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ: не менее 5 МГц;
- $I_{ко}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб}=60$ В: не более 1 мкА;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 20 пФ.
- $U_{кб\ max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база: 60 В;
- $U_{бэ\ max}$ - Максимальное напряжение база- эмиттер: 5 В;
- $I_{к\ max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 150 мА;
- $I_{к\ и\ max}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 350 мА;
- $P_{к\ max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 350 мВт;
- $t_{п}$ - Температура p-n перехода: не более 125°C;
- $t_{окр}$ - Температура окружающей среды: -40...+85°C.